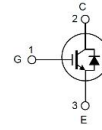


TRW(E/G)5065NH1 是 50A, 650V 高可靠性 IGBT, 具有高速开关特性、及低导通损耗和开关损耗等特点。

1.主要特征

- 50A , 650V , $V_{CE(sat)}=1.8V @ I_C=50A$
- 饱和压降为正温度系数, 易于并联使用
- 低开关损耗
- 内置快恢复二极管
- 高速开关特性
- 高可靠性及热稳定性, 良好的参数一致性

封装类型:



TO-3PF



TO-247



TO-3P

2.极限参数 (除非另有说明 , $T_A = 25^{\circ}C$):

符号	参数	参数范围	单位
V_{CE}	集电极-发射极电压	650	V
V_{GE}	栅极-发射极电压	± 20	V
I_C	集电极电流 ($T_c=25^{\circ}C$)	80	A
	集电极电流 ($T_c=100^{\circ}C$)	50	A
I_{Cpulse}	集电极脉冲电流	150	A
I_F	二极管正向电流($T_c=25^{\circ}C$)	10	A
	二极管正向电流($T_c=100^{\circ}C$)	5	A
I_{Fpulse}	二极管脉冲电流	15	A
P_{tot}	耗散功率 ($T_c=25^{\circ}C$) (TO-247)	216	W
	耗散功率 ($T_c=100^{\circ}C$) (TO-247)	86	W
P_{tot}	耗散功率 ($T_c=25^{\circ}C$) (TO-3PF)	68	W
	耗散功率 ($T_c=100^{\circ}C$) (TO-3PF)	27	W

参数	V_{CE}	$V_{CE(sat)}$	V_F	$T_{j,Max}$	Eon	Eoff
值	650V	1.8V	1.5V	150°C	1.2mJ	1.4mJ

3.产品应用

- 逆变器
- UPS 电源等领域